

FACULTY OF FOUNDRY ENGINEERING

XXXIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE FOUNDRYMAN' DAY 2015



Krakow, 19 – 20 Nov. 2015

ROZKŁAD WIELKOŚCI PODŁOŻA DO ZARODKOWANIA HETEROGENICZNEGO FAZY PIERWOTNEJ STOPU Al-Cu

Janusz Lelito¹, Beata Gracz^{*2}, Paweł L. Żak³, Józef Sz. Suchy⁴, Michał Szucki⁵, Paweł Malinowski⁵ AGH Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Odlewnictwa. ul. Reymonta 23, 30-059 Krakow ^{*}gracz@agh.edu.pl

Słowa kluczowe: rozkład logarytmiczno-normalny, rozkład Oldfielda, rozkład eksponecjalny;

1. Wprowadzenie

W numerycznym modelowaniu struktury odlewów wykorzystuje się równania opisujące funkcję gęstości ziaren w zależności od stopnia przechłodzenia [1 - 3], bądź jak ma to miejsce w przypadku modelu FreeGrowth, rozkład wielkości podłoża do zarodkowania heterogenicznego [4 - 6]. Jednym z głównych założeń modelu FreeGrowth jest logarytmiczno-normalny rozkład wielkości podłóż do zarodkowania heterogenicznego. Z tych też względów zagadnienie zarodkowania jest przedmiotem licznych badań teoretycznych i doświadczalnych [1 - 7]. Efektem tych badań są różne prawa zarodkowania. Najczęściej wykorzystywane do numerycznego modelowania procesu krystalizacji są następujące zależności: Oldfielda [1], eksponencjalny [3] i logarytmiczno normalny [4 - 6]. Występujące w tych zależnościach parametry określone są empirycznie dla każdego stanu fizykochemicznego ciekłego metalu. Zasadniczym celem tej pracy jest wyznaczenie w powyższych równaniach, parametrów dopasowania krzepnącego stopu Al-Cu na podstawie badań doświadczalnych zamieszczonych w literaturze [8] a następnie ich porównanie.

2. Wyniki

W celu określenia kinetyki zarodkowania stopu Al-Cu posłużono się zależnościami empirycznymi, które są wykorzystywane przy numerycznym modelowaniu procesu krystalizacji.

Zależność Oldfielda: $N_V = Y \Delta T^n, m^{-3}$ (1)

Zależność eksponencjalna: $N_V = \lambda \exp(-b/\Delta T), m^{-3}$ (2)

Zależność logarytmiczno-normalna:

$$n(d) = \frac{N_0}{\sigma \cdot d \cdot \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{\left[\ln(d) - \ln(d_0)\right]^2}{2 \cdot \sigma^2}\right), m^{-3}$$
(3)

gdzie: *Y*, *m*, λ i *b* – parametry krystalizacji, które można wyznaczyć doświadczalnie, N_0 – zakładana totalna populacja podkładek/podłoży zarodkowania (zarówno aktywnych jak i nieaktywnych), d_0 – średnia geometryczna rozkładu log-normal, σ – odchylenie standardowe dystrybucji, d – średni wymiar charakterystyczny (sprowadzona średnica) powierzchni podłoża do zarodkowania heterogenicznego.

Aby wyznaczyć parametry krystalizacji do powyższych zależności (1), (2) i (3), wykorzystano dane doświadczalne z literatury [8].

Wyniki analizy statystycznej dla modelu Oldfielda i eksponencjalnego zestawiono i pokazano na rysunku 1.



Rys. 1. Wpływ stopnia przechłodzenia na gęstość ziaren fazy pierwotnej α (Al) w stopie Al-Cu według modelu: *a* - Oldfielda (N_v=(0,0247)* Δ T^(2,61)) i *b* - eksponencjalnego (N_v=(131,555)*exp(-(25.39)/ Δ T))

Na rysunku 1 zostały naniesione wyniki eksperymentalne z literatury [8] wraz z krzywymi korelacyjnymi, uzyskanymi dzięki programowi komputerowemu STATISTICA. Wyznaczone zostały również parametry krystalizacji dla modelu Oldfielda i eksponencjalnego opisujących kinetykę zarodkowania.

Dla wyznaczenia parametrów w równaniu (3) wykorzystano algorytm opisany w literaturze [7]. Wyniki obliczeń zamieszczono w postaci graficznej na rysunku 2.



Na rysunku 3 zastawiono wyniki eksperymentalne pochodzące z literatury [8] z obliczeniami bazującymi na powyższych modelach zarodkowania. Jak można zauważyć na rysunku 3, modele zarówno Oldfielda, eksponencjalny jak i logarytmiczno-normalny poprawnie opisują zależność gęstości ziaren od przechłodzenia. Wszystkie modele wykazują duże odstępstwo od wyników eksperymentalnych dla przechłodzenia równego około 11 K. Dla pozostałych wartości przechłodzeń model logarytmiczno-normalny wydaje się być bliższy wynikom eksperymentalnych.



Rys. 3. Zestawienie wyników doświadczalnych [1] z modelami ujmującymi gęstość ziaren w funkcji przechłodzenia

Wnioski

- 1. Dane doświadczalne mogą być poprawnie opisane równaniami (1), (2) i (3).
- 2. Analiza statystyczna umożliwiła wyznaczenie parametrów krystalizacji dla trzech zależności opisujących kinetykę zarodkowania.
- Uzupełnione modele zarodkowania o parametry krystalizacji wyglądają następująco: Model Oldfielda: N_V=(0,0247)*ΔT^(2,61), Model eksponencjalny: N_v=(131,555)*exp((-25,39)/ΔT). Model logarytmiczno-normalny:

$$N(d) = \frac{1 \cdot 10^{11}}{1.580 \cdot d\sqrt{2\pi}} \cdot \exp\left(-\frac{\left[\ln(d) - \ln(2.165 \cdot 10^{-10})\right]^2}{2 \cdot 1.580^2}\right)$$

Podziękowania

Opracowano w ramach projektu nr 11.11.170.318 zad. 1

Literatura

- 1. W. Oldfield, Quantitative Approach to Casting Solidification, Freezing of Cast Irone ASM 59 (1966) str. 945-961.
- 2. M. Górny, Badania modelowe zarodkowania ziaren eutektycznych w żeliwie i ich weryfikacja doświadczalna. Rozprawa doktorska, Kraków 2001.
- 3. E. Fraś, K. Wiencek, M. Górny and H. Lopez, Theoretical Model for Heterogeneous Nucleation of Grains During Solidification, Material Science and Technology, December 19 (2003) pp. 1653-1659.
- 4. A. L. Greer, A. M. Bunn, A. Tronche, P. V. Evans, D. J. Bristow, MODELLING OF IN-OCULATION OF METALLIC MELTS: APPLICATION TO GRAIN REFINEMENT OF ALUMINIUM BY AI-Ti-B, Acta Materialia 48 (2000) pp. 2823-2835.
- 5. T. E. Quested, A. L. Greer, The effect of the size distribution of inoculant particles on ascast grain size in aluminium alloys, Acta Materialia 52 (2004) pp. 3859-3868.
- 6. T. E. Quested, A. T. Dinsdale, A. L. Greer, Thermodynamic modelling of growth-restriction effects in aluminium alloys, Acta Materialia 53 (2005) pp. 1323-1334.
- J. Lelito, B. Gracz, P. L. Żak, M. Szucki, D. Kalisz, J. Suchy, W. Krajewski, Determination of substrate log-normal distribution in the AZ91/(SiC)p composite, Archives of Foundry Engineering (13) 3/2013 pp. 35-38.

 M. Górny, G. Sikora, Effect of Titanium Addition and Cooling Rate on Primary α(Al) Grains and Tensile Properties of Al-Cu Alloy, Journal of Materials Engineering and Performance 24 3 (2015) pp. 1150-1156.